BUNSEKI KAGAKU Vol. 55, No. 7, pp. 457–465 (2006) © 2006 The Japan Society for Analytical Chemistry

### 総合論文

# 表面第二高調波発生分光法を用いる界面吸着 ローダミン B の会合状態解析

山口 央<sup>1</sup>,内田 達也<sup>1,2</sup>,伊奈 知美<sup>1</sup>,能智 公久<sup>1</sup>,寺前 紀夫<sup>®1</sup>

第二高調波発生(second harmonic generation, SHG)分光法は,表面・界面領域でのみ発現する二次の 非線形光学現象を利用した表面・界面の選択的分光分析手法であり,吸着分子の吸着量や分子配向性解析等 へ応用されている.著者らは,SHGの入射レーザー波長依存性であるSHGスペクトルが界面吸着分子の電 子スペクトルに対応する点に着目し,SHGスペクトル測定装置の開発を行い,界面吸着分子の状態解析へ の応用を行ってきた.本論文では,装置の概略及び測定条件について述べるとともに,SHGスペクトル測 定によりローダミンBのヘプタン/水界面あるいは石英/水界面における特徴的な会合状態について明らか にした.

#### 1 緒 言

混じり合わない二相が接する界面領域は、クロマトグラ フィーや液液抽出、化学センサーなど多くの分析手法にお ける重要な反応場の一つであり,界面領域における化学過 程を原子・分子論的に理解することは、分析手法の発展に おいて必要不可欠である.界面張力測定や電気化学測定 は,反応速度や吸着定数など熱力学的なパラメーターの解 析に用いられており、化学過程の量論的な知見を与えるも のである<sup>1)</sup>. 分子構造や会合構造といった分子レベルでの 構造に関しては、分光学的測定手法によって直接的な情報 を得ることができる.一般に、バルク溶液相に存在する化 学種の構造や会合状態などの構造解析は、光をプローブと した電子スペクトルや振動スペクトル、磁場をプローブと した核磁気共鳴(NMR)スペクトルの測定によって行わ れている.しかし、これらの分光法では、バルク溶液相に 存在する化学種の妨害を排除して界面吸着分子種のみを選 択的に分離計測することは困難である.界面に形成する非 常に薄い分子層の直接観測のためには、界面のみで発現す る物理現象を利用した分光法が求められる.

光学的非線形現象を利用した第二高調波発生(second harmonic generation, SHG)分光法は、界面選択的分光 分析手法として 1980 年代から研究・開発が行われてき  $c^{2)\sim6}$ .光学的非線形現象とは、周波数が  $\omega_1$  及び  $\omega_2$  であ る二つの入射光 (基本波)の混合によって和周波

 $(\omega_{sum} = \omega_1 + \omega_2)$ が発生することであり、単一の基本波 を用いた際に発生する周波数が2倍である第二高調(second harmonic, SH)波を利用するのがSHG分光法であ る.SH波を発生する要因となる非線形分極は、電子双極 子近似の範囲で等方性結晶やアモルファス固体や溶液,気 体バルク中では誘起されず、対称性の低下した界面領域で のみ誘起される(Fig.1).このように、非線形分光法は 特定の分子配向性を持って界面領域に存在する分子にのみ 感度を有するため、界面吸着分子のみを選択的に分離計測 することが可能である。全反射光学系でのエバネッセント 波を利用した吸収や蛍光スペクトル測定も界面選択的分光 分析手法として広く用いられているが、これらの観測領域 がエバネッセント波のしみこみ深さ(数十一数百 nm)で あることを考えると、非線形分光法の界面選択性は著しく 高いと言える。

SHG分光法は、石英基板上にキャストした色素分子など固/気界面吸着分子の配向評価<sup>7)</sup>や単結晶電極表面の結



Fig. 1 Scheme of second harmonic generation at the liquid/liquid interface

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> 東北大学大学院理学研究科化学専攻:980-8578 宮城県仙台市 青葉区荒巻字青葉 6-3

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> 現在所属 東京薬科大学生命科学部環境生命科学科:192-0392 東京都八王子市堀之内1432-1



M: Aluminum Mirror, F: Fresnel Rhomb, P: Polarizer F1: Long Pass Filter, F2: Short Pass Filter, L: Lens, BS: Beam Splitter, PMT: Photomultiplier Tube, ARM: Automatically Rotable Mirror M: Monochlomator



晶構造解析手法<sup>8)9)</sup>として応用され始めた.しかし,SHG 研究の当初は、単一波長のレーザー光を基本波として測定 が行われ、配向解析や吸着量の指標としての利用が主であ った.一方,入射基本波あるいは SH 波の波長が界面吸着 分子の電子遷移に共鳴する場合に SHG が飛躍的に増大 し、入射基本波の波長掃引によって SHG スペクトルが得 られる<sup>10)</sup>. SHG スペクトルは,界面吸着分子に対する紫 外可視吸収スペクトルと対応する<sup>2)11)</sup>ことから、界面にお ける分子の電子状態に関する直接的な情報を与える. SHG スペクトルに関する実験は、1982 年の Y. R. Shen ら による固/気界面に形成した色素分子の観測10)が初めてで ある. その後, 波長可変レーザーの技術進展に伴って 1990年代後半から界面吸着分子の状態解析への応用が活 発になった. 例として, 極性プローブ色素分子を用いた界 面領域の極性に関する研究<sup>12)13)</sup>,あるいは界面吸着分子の 会合状態<sup>14)15)</sup>や酸解離状態<sup>16)</sup>, 錯形成過程<sup>17)</sup>の研究などが |挙げられる.更に,界面キラリティーの研究<sup>18)~20)</sup>などへ の応用を目指した SHG 円偏光二色性スペクトル測定が行 われている. 最近ではリポソームや細胞膜の観測手段とし ての SHG 顕微鏡<sup>21)~23)</sup>が分子生物学分野で注目を集めてい る.

SHG スペクトルの測定では,媒質中の屈折率分散によって SH 波の進行方向が入射波長で変化するという計測光 学系上の問題があるが,著者らは,これまでに基本波の波 長掃引と連動した補正光学系を組むことで解決を図り, SHG スペクトル測定システムの開発を行ってきた.

本稿では、著者らが開発してきた SHG スペクトル測定 システムを紹介するとともに、SHG スペクトル測定によ って解析されたヘプタン/水界面及び trimethylchlorosilane で表面修飾した石英と水の界面(TMS-石英/水界面) におけるローダミン色素の会合状態について報告する.

#### 2 表面第二高調波測定システム

試作した SHG 測定装置の概略図を Fig. 2 に示す<sup>24)</sup>. Q スイッチモードロック Nd:YAG レーザー(パルス幅: 30 ps, 繰り返し: 10 Hz, EXPLA PL2143B)を LBO 結晶を 用いた光パラメトリック発信器(OPG, EXPLA 401VIR) に導入し, 波長範囲 420~680 nm のレーザー光を基本波 として用いた. 基本波の偏光は偏光子,フレネル・ロムを 用いて制御し,カラーフィルターにより光路内で発生した SH 光成分を除去した後,プリズムを介して基本波を界面 に対して全反射条件下で入射した. 試料界面から発生する SH 光の出射角度は入射基本波の波長によって変化する (Fig. 1).

$$n_{2\omega}\sin\theta_{2\omega} = n_{\omega}\sin\theta_{\omega} \tag{1}$$

式(1) で示される屈折率の波長分散効果を補正するた めに、2枚の自動制御回転ミラーを用いて測定するすべて の波長のSH光を分光器に導入した.SH光の偏光成分は、 偏光子を用いて任意に選択した.SH光強度は光電子増倍 管を用いて検出し、デジタルオシロスコープを用いて積算 した.また、試料直前で分岐した基本波強度を同時に測定 し、得られたSH光強度を基本波強度の2乗で除すること で、基本波強度の変動を補正した.本稿で紹介するローダ ミンB(RB)のSHGスペクトル測定は、入射基本波の波 長を480~630 nmの波長範囲で2~3 nm ステップの波長 掃引を行っている.一つのスペクトルを取得するために要 する時間はおよそ3~5分程度である.

#### 3 SHG 測定条件の検討

界面から発生する SHG は、電子双極子近似の範囲では 界面由来の非線形感受率と界面吸着種由来の非線形感受率 の和によって記述される<sup>25)</sup>.ここで、入射基本波あるいは SH 波の波長が界面吸着種の電子遷移に共鳴する場合に は、吸着種由来の非線形感受率が飛躍的に増大し、他の非 線形感受率項の影響を無視することができる.非線形感受 率は基本波の  $3 \times 9$  のテンソル成分であるが、このうち界 面吸着分子の非線形感受率は吸着分子の対称性によって 0 となる成分が存在する.特に、分子が界面に対して垂直な 軸を中心とした回転方向に対して等方的に存在する場合 は、 $\chi_{ssc} = \chi_{stx}, \chi_{stx}$ の4成分のみが有効であり、実 質的には3成分のみで表面 SH 電場が記述される<sup>21</sup>.入射 面に対して電場偏光面が平行な(p-偏光) SH 波成分の強 度 $I_p(2\omega)$ と垂直な (s-偏光) SH 波成分の強度 $I_s(2\omega)$  は 以下の式で表される<sup>26</sup>.



Fig. 3 Dependence of the SH intensity on the incident angle

Fundamental light (1064 nm) and SH light (532 nm) are *s*-polarized and *p*-polarized, respectively. Closed circles are the experimental data and the solid curve is the theoretical one which is calculated by using a combination of Fresnel coefficients proposed by Marowsky<sup>27)28)</sup>.

$$I_{s}(2\omega) \propto \left| \frac{a_{1}}{\varepsilon_{m}(\omega)} \chi_{xxz} \sin 2\gamma \right|^{2} I(\omega)^{2}$$
 (2)

$$I_{p}(2\omega) \propto \left| \left( \frac{a_{2}}{\varepsilon_{m}(\omega)} \chi_{xxx} + \frac{a_{3}}{\varepsilon_{m}(2\omega)} \chi_{zxx} + \frac{a_{4}}{\varepsilon_{m}^{2}(\omega)\varepsilon_{m}(2\omega)} \chi_{zxz} \right) \right| \\ \cos^{2}\gamma + \frac{a_{5}}{\varepsilon_{m}(2\omega)} \chi_{zxx} \sin^{2}\gamma \right|^{2} I(\omega)^{2}$$
(3)

ここで、 $\gamma$ は入射面に対する偏光角(p-偏光: $\gamma = 0^{\circ}$ )である. $a'_n$ ( $n = 1 \sim 5$ )は入射基本波及び第二高調波に 関する試料界面あるいはプリズム表面でのフレネル係数の 組み合わせであり、入射基本波の入射角度と媒質(用いた プリズム、ヘプタン、水)の屈折率によって記述される.  $\varepsilon_m(\omega)$ 及び $\varepsilon_m(2\omega)$ は、それぞれ入射基本波及びSH波の 波長における吸着分子層の誘電率である.表面SHGに関 するフレネル係数に関しては、これまでに幾つかの理論的 考察が報告されているが、試作したSHG測定システムを 用いて石英/空気界面におけるSH光強度の入射角度依存 性を測定したところ、測定結果は、Fig. 3に示すとおり、 Marowsky らによって提案されているSH光強度の入射角 度依存性の理論式<sup>27)28)</sup>とよく対応していた<sup>24)</sup>.そこで、以 降のSHG測定結果はすべて Marowsky によって提案され たフレネル係数の組み合わせを用いて解析を行った.

SHG スペクトル及び SHG の入射偏光依存性測定結果の 解析においては、式(2)、(3) で示すとおり、吸着分子 層の誘電率を考慮に入れる必要がある。そこで、石英基板 上に形成した RB 膜の吸収スペクトル、及びその Kramers-Kronig 解析により算出<sup>29)</sup>した RB 膜(Fig. 4)の屈折率を 用いて、SHG スペクトルに与える吸着分子層の誘電率の



**Fig. 4** Absorption spectrum of **RB** dip film on a quartz substrate and its dielectric constant calculated by Kramers-Kronig analysis

Chemical structure of RB is shown in inset.

影響を検討し,SHGスペクトル測定条件を決定した.RB 膜は,後述のTMSで表面処理した石英基板をRB水溶液 に浸漬後一定速度で引き上げることで作製した.

RB 膜の誘電率は、入射基本波の波長範囲(480~630 nm)で RB の S<sub>0</sub>-S<sub>1</sub> 遷移に由来する波長分散を示すのに対 し、第二高調波の波長範囲(240~315 nm)ではほぼ一 定の値である. SHG スペクトルでは、界面吸着種の非線 形感受率の波長依存性を評価する. したがって、波長依存 性が顕著である  $\varepsilon_m(\omega)$  項が含まれていると、実測した SHG スペクトルから非線形感受率項を評価することが困 難になる. 特に RB 吸着量が多い場合には、 $\varepsilon_m(\omega)$ の影響 が顕著となるはずである. 式(3)から s-偏光の入射基本 波を用いた場合、p-偏光成分の SH 光強度  $I_{ps}$ は式(4)で 表されるとおり波長依存性が顕著である  $\varepsilon_m(\omega)$  項は含ま ず、波長依存性の小さい  $\varepsilon_m(2\omega)$ のみで記述される.

$$I_{ps}(2\omega) \propto \left| \frac{a_5}{\varepsilon_{\rm m}(2\omega)} \chi_{zxx} \right|^2 I(\omega)^2 \tag{4}$$

このように, RB の SHG スペクトル測定においては偏 光条件を *s*-偏光入射, *p*-偏光検出とした.

4 水溶液中におけるローダミンBの会合状態

RB は,水溶液中で濃度がμM (M = mol dm<sup>-3</sup>)以上で 二量体を形成することが報告されている<sup>30)~32)</sup>.そこで, 吸収スペクトル測定によって水溶液中における RB 二量体 の組成比と構造について解析を行った.Fig. 5 (a) に RB 水溶液の吸収スペクトルを示す.RB 濃度が 1.0 μM で観 測される吸収スペクトルは RB 単量体のみに由来すると考 えられ,その極大波長は 557 nm である.この吸収ピーク は RBのキサンテン骨格の長軸方向に沿った So-S1 遷移で ある. RB 濃度の増加に伴い, 557 nm 近傍の吸収が減少 する一方,539 nm に等吸収点を伴って短波長側の525 nm 近傍に新たな吸収ピークが現れている. これらの吸収 スペクトル変化は濃度増大に伴う RB 二量体の形成を意味 **する**. RB 二量体の解離定数を解析したところ, K<sub>d</sub> = 6.8 ± 0.5 × 10<sup>-4</sup> M であり、これまでに報告されている解 離定数  $(6.8 \times 10^{-4} \text{ M}, {}^{30)} 7.3 \times 10^{-4} \text{ M}, {}^{31)} 7.2 \times 10^{-4} \text{ M}^{32)})$ とほぼ対応した値が得られた.更にこの解離定数を用い て,吸収スペクトルの実測値から RB 二量体の吸収スペク トルを計算すると, Fig. 5 (b) に示すように, 二つの吸 収ピークを有するスペクトルとなった. 色素分子の会合構 造と吸収スペクトルの関係は励起子分裂理論によって説明 され, Fig. 5 (b) に示す RB 二量体の吸収スペクトルは, sandwich 型二量体の S<sub>0</sub>-S<sub>1</sub> 遷移の分裂によると考えられ る<sup>33)</sup>. このように,水溶液中において RB は単量体と



**Fig. 5** (a) Absorption spectra of RB aqueous solutions. (b) Absorption spectra of monomeric (solid line) and dimeric (dashed line) forms of RB in the aqueous solution

sandwich 型二量体の平衡状態にあることが分かる.なお, それぞれの RB 濃度における二量体の組成比について算出 した結果を Table 1 に示す.

#### 5 ヘプタン/水界面における RB 会合構造

入射基本波あるいは第二高調波の波長が界面吸着種の電 子遷移に共鳴する場合には,吸着種由来の非線形感受率  $\chi_{ads}$ が飛躍的に増大する.本実験では,入射基本波の波長 範囲(480~620 nm)がローダミン色素の $S_0$ - $S_1$ 遷移に一 致しているため,共鳴効果により吸着 RB の SHG が大き な強度で観測でき,ヘプタンもしくは水分子由来の非線形 感受率項は無視できる.この場合,SH 光強度 $I(2\omega)$ の入 射波長依存性は以下の式で表される<sup>12</sup>.

$$I(2\omega) \sim \left|\chi_{\rm ads}^{(2)}\right|^2 I^2(\omega) \tag{5}$$

$$\chi_{\rm ads}^{(2)} = \frac{a}{1/\lambda_{\rm max} - 1/\lambda + i\Gamma} + b \tag{6}$$

 $I(\omega)$ は入射基本波強度, $\chi_{ads}^{(2)}$ は吸着種及び界面に由来 の表面非線形感受率,a,b, $\Gamma$ ,  $\lambda_{max}$ は $\chi_{ads}^{(2)}$ の共鳴及び非 共鳴項の強度,スペクトル幅,極大波長である.

ヘプタン/水界面に吸着した RB の SHG スペクトルを Fig. 6 (a) に示す. RB 水溶液の濃度([RB]) は 1.0×  $10^{-7} \sim 1.0 \times 10^{-3}$  M の範囲であり,すべての RB 溶液濃 度において単一のピークが観測された.得られた SHG ス ペクトルを式(5),(6)を用いて解析し,ピークの極大 波長とその波長での SH 光強度の平方根( $\sqrt{I(2\omega)}$ )を [RB] に対してプロットしたのが Fig. 6 (b) である.  $\sqrt{I(2\omega)}$ は RB 吸着量と比例関係にあり, Langmuir 型吸着 を仮定すると, $\sqrt{I(2\omega)}$ は [RB] に対して以下の関係が成 り立つ.

$$\sqrt{I(2\omega)} = \frac{K_{\text{ads}}\sqrt{I_{\text{max}}(2\omega)}[\text{RB}]}{1 + K_{\text{ads}}[\text{RB}]}$$
(7)

ここで、 $K_{ads}$ 、 $\sqrt{I_{max}(2\omega)}$ はそれぞれ吸着平衡定数、飽 和吸着時のSH光強度である.式(7)を用いた解析によって、[RB]がおよそ  $1.0 \times 10^{-5}$  M で飽和吸着となること が分かった.

SHG スペクトルは、ピークの極大波長が水溶液中での

Table 1 Molar fraction of RB making up the sandwich dimmer in bulk aqueous solution

[RB]/M	$1.0 \times 10^{-5}$	$1.0 \times 10^{-4}$	$5.0 \times 10^{-4}$	$1.0  imes 10^{-3}$
Molar fraction <sup>a)</sup>	0.03	0.19	0.45	0.56

a) Molar fraction: [dimmer]/[monomer]



**Fig. 6** (a) Normalized SHG spectra of RB at the water/heptane interface for  $1.0 \times 10^{-7}$  M,  $1.0 \times 10^{-7}$  M, and  $1.0 \times 10^{-7}$  M of RB concentrations in the bulk water phase ([RB]). (b) Peak maxima ( $\lambda_{max}$ ) and those intensities at the various RB concentrations ([RB])

The solid line is the theoretical fit with eq. (7).

RB 単量体の吸収極大波長に比べておよそ 20 nm 以上長波 長側にあり,これは界面において RB が in-plane 型会合体 を形成していることを示す. in-plane 型会合体の会合数 *n*, 斜角  $\phi$ ,分子間距離 *r*,遷移双極子モーメント  $|\mu|^2$ と極大 波長のシフト幅 Δ*E* の関係は式(8) で表される<sup>33)</sup> (Fig. 7).

$$\Delta E = 4 \left( \frac{n-1}{n} \right) \frac{|\mu|^2}{r^3} \left( 1 - 3\cos^2 \phi \right)$$
 (8)

Fig. 6 (b) に示すとおり, RB 吸着量の増大とともに SHG スペクトルで観測されるピークの極大波長が長波長 シフトしている.このように, ヘプタン/水界面において は吸着量の増大に伴って, 会合数, 斜角, 分子間距離のい ずれかが変化することで極大波長が長波長シフトしたと考 えられる.Fig. 6 (b) に示す吸着等温線から RB 溶液濃度 が  $1.0 \times 10^{-5}$  M のとき RB の界面被覆率が 1.0 と算出され た.そこで, 被覆率 1.0 以下での in-plane 型会合体の斜角 を SHG の入射偏光依存性測定により推定し, 吸着量増大 に伴うピーク波長のレッドシフトについて検討した.

SHG の入射偏光依存性は、それぞれの RB 溶液濃度で



**Fig. 7** (a) Scheme of in-plane associate of RB at an interface, and (b) energy diagram of in-plane dimmer



**Fig. 8** Input polarization dependence of the (a) *p*-polarized and (b) *s*-polarized SH light from RB at the heptane/water interface:  $[RB] = 1.0 \times 10^{-7}$  M (open circles),  $2.0 \times 10^{-7}$  M (open squares),  $1.0 \times 10^{-5}$  M (closed circles)

Each polarization curve was normalized to a maximum SH intensity obtained from theoretical fitting of the SH responses. The input polarization angle is defined as  $0^{\circ}$  for *p*-polarized fundamental light and  $90^{\circ}$  for *s*-polarized fundamental light. The solid lines are the theoretical fits with eq. (2) or eq. (3).

得られた SHG スペクトルの極大波長を入射波長として測 定を行った. Fig. 8 は,溶液濃度( $1.0 \times 10^{-7}$  M,  $2.0 \times 10^{-7}$  M,  $1.0 \times 10^{-5}$  M)の RB 水溶液を用いた際の測定結 果であり,界面被覆率はそれぞれ 0.32, 0.50, 1.0 に対応 する. SHG の入射偏光依存性は界面被覆率にかかわらず ほぼ一定の挙動であり,界面被覆率が 0.32~1.0 の範囲に おいて RB の分子配向性がほぼ一定であることが分かっ た.更に,入射偏光依存性の測定結果を式(2),(3)を



Fig. 9 SHG spectra of RB at the TMS-modifiedquartz/water interfaces: contact angles of TMS-modified-quartz surface are (a)  $\theta = 78^{\circ}$  and (b)  $\theta = 51^{\circ}$ The concentrations of RB in the bulk aqueous phase are (a1)  $5.0 \times 10^{-7}$  M, (a2)  $1.0 \times 10^{-5}$  M, (a3)  $1.0 \times 10^{-4}$  M, and (a4)  $1.0 \times 10^{-3}$  M. The concentrations of RB in the bulk aqueous phase are (b1)  $5.0 \times 10^{-6}$  M, (b2)  $1.0 \times 10^{-5}$  M, (b3)  $1.0 \times 10^{-4}$  M, (b4)  $5.0 \times 10^{-4}$  M, (b5)  $1.0 \times 10^{-3}$  M.

用いて各非線形感受率項を算出し, Fig. 7 (a) で示す斜 角 (φ)の計算を行った. 非線形感受率項の算出において 吸着層の誘電率を測定により求める必要があるが, 液/液 系においては困難である. そこで, 固/気界面で得られた 吸着層の誘電率 (Fig. 4)を用い, ここでは近似的に非線 形感受率項の算出を行い, 式(9)を用いて<sup>29)</sup>斜角を計算 した.

$$\cos^{2}(90-\phi) = \frac{\chi_{zzz}}{3\chi_{zzz} + 2\chi_{zxx} + 2\chi_{xxz}}$$
(9)



**Fig. 10** Oblique angles of in-plane associates formed at the TMS-modified-quartz/water interface for various concentrations of RB in the bulk water phase ([RB])

The contact angle of the TMS-modified-quartz surface is  $78^{\circ}$ . The oblique angle defined in Fig. 7 (a) was estimated by an analysis of input polarization dependence of SHG using eq. (5) and (6).

計算した斜角は各被覆率においておよそ 20° であり,キ サンテン環がほぼ平行な配向角で RB が吸着していること が示唆された. Fig. 7 に示すように, in-plane 型の斜角が 54.7°以下で吸収極大波長の長波長シフトが理論的に予測 され,算出された斜角の値は,長波長シフトを引き起こす in-plane 型会合体の斜角として適当な値と言える.更に, 斜角が界面被覆率によらず一定であった結果から,界面被 覆率の増大による SHG スペクトルの極大波長シフトが, 会合数の増加と分子間距離の減少に起因することが示唆さ れた.

#### 6 TMS 修飾石英/水界面における会合状態

次に、固体基板として石英を用い、疎水性アルキルシラ ン剤であるトリメチルクロロシラン(TMS)で表面修飾 した石英/水界面に吸着した RB の会合構造について検討 した. TMS 修飾は以下のように行った. 石英プリズムを 表面洗浄した後、TMS のドライトルエン溶液中(40 ml TMS in 400 ml トルエン)で 16 時間還流した<sup>34)</sup>. 石英プ リズム表面に TMS を修飾した後、塩酸溶液中で TMS を 超音波処理などにより剥離することで TMS 修飾量を制御 し、接触角測定により修飾状態を評価した. 接触角測定 は、TMS 修飾石英基板上に水滴を滴下し、飽和蒸気下で 行った.

TMS 修飾量が最も大きい場合(接触角 θ = 78°)の SHG スペクトルを Fig. 9(a)に,入射偏光依存性により 推定された配向角を Fig. 10に示す. ヘプタン/水界面と 同様に,いずれの SHG スペクトルにおいても水溶液中で の RB 単量体の吸収極大波長よりも長波長側に単一のピー クが存在していることから, RB はヘプタン/水界面と同



**Fig. 11** SHG spectra depend on the contact angle of TMS-modified quartz surface:  $\theta = 78^{\circ}$  (closed circles),  $\theta = 73^{\circ}$  (open circles), and  $\theta = 51^{\circ}$  (open triangles)

The concentration of RB in bulk aqueous phase is  $1.0 \times 10^{-3}$  M.

様な in-plane 型会合体の形成が確認された.更に SHG ス ペクトルでは RB 吸着量に対応するピーク強度の増大とと もに極大波長の長波長シフトが観測された.また,推定さ れた斜角はヘプタン/水界面と同値であり,吸着量とピー クの極大波長によらずほぼ一定であった.これらの結果か ら,吸着量の増大に伴う会合数の増加と分子間距離の減少 が示唆された.このように,TMS 修飾量が最も大きい場 合に界面で形成する RB 会合体構造は,ヘプタン/水界面 とほぼ同様であることが明らかとなった.

次に, TMS 修飾量が最も少ない場合(接触角  $\theta$  = 51°) の SHG スペクトルの RB 溶液濃度依存性を Fig. 9(b) に 示す. 希薄溶液 (5.0×10<sup>-6</sup> M) からの吸着では 564 nm 付近に極大を有するスペクトルが得られた. この極大波長 は、バルク水溶液中における RB 単量体の吸収極大波長 (557 nm) に対して若干長波長シフトしているが、水より 低極性溶媒中における RB 単量体の極大波長 563 nm: poly(methacrylic acid)<sup>35)</sup>, 562 nm: グリセロール<sup>36)</sup>} とよ く対応している. TMS で疎水化処理した石英と水の界面 はバルク水中に比べて低極性であり13)37),希薄溶液からの 吸着で観測された極大波長(564 nm)はTMS石英/水界 面における RB 単量体に由来すると考えられる.一方, SHG スペクトルの RB 溶液濃度依存性では, RB 溶液濃度 の上昇によるスペクトル強度の増大とピーク波長のシフト が観測された. RB 溶液濃度が 1.0×10<sup>-4</sup> M までは, RB 溶液濃度の上昇に伴ってスペクトル強度が増大するととも に,界面吸着 RB 単量体の極大波長に比べて長波長側 (578 nm) に新たなピークが成長している. 長波長側のピ ークは,前述の in-plane 型会合体に由来し,吸着量の増 大とともに in-plane 型会合体が界面において優先的に形 成していることが示された.一方, RB 溶液濃度が 1.0× 10<sup>-4</sup> M 以上の高濃度溶液では,580 nm のピークに対して 565 nm と 515 nm の二つのピークが顕著となってくる. これら二つのピークの極大波長は Fig. 5(b) で示す sandwich 型二量体の吸収極大波長と対応し,界面における sandwich 型二量体に由来すると考えられ、高濃度溶液か らの吸着では sandwich 型二量体が優先的に界面に存在し ていることが示された.このように、TMS 修飾量が低い 場合, in-plane 型会合体と sandwich 型二量体が共存し, それらの存在割合が RB 溶液濃度によって変化することが SHG スペクトルから明らかとなった. なお, sandwich 型 二量体に由来する 515 nm 近傍のピーク強度は、水溶液中 における sandwich 型二量体の存在比(Table 1)が低い 場合には観測されず (Fig. 9, b1, b2),存在比が 0.2 以 上となる RB 溶液濃度で顕著となり、存在比が 0.56 であ る [RB] = 1.0×10<sup>-3</sup> M において,515 nm 近傍のピーク強 度が最も大きく観測された (Fig. 9, b3~b5). これらの 結果から,界面において観測される sandwich 型二量体が 水溶液中で形成した sandwich 型二量体の吸着に起因する と考えられる.

TMS 修飾量が低い場合,TMS が存在していない石英表面への RB の吸着が考えられる.しかしながら,TMS を修飾していない石英と水の界面で観測された SHG スペクトル強度は微弱であり,Fig.9で示す SHG スペクトルは,石英表面のTMS に吸着した RB に由来すると結論した.

Fig. 11 は, sandwich 型会合体が最も顕著に観測される 溶液濃度  $(1.0 \times 10^{-3} \text{ M})$  で観測した SHG スペクトルの TMS 被覆率依存性である. 低被覆率では, sandwich 型二 量体の形成を示す 515 nm 近傍のピークと 565 nm 近傍の ピークが顕著である. 被覆率の増大に伴って両ピークは減 少し, 580 nm 近傍に in-plane 型会合体形成を示すピーク が顕著になる. 以上の結果から,予想される TMS 修飾石 英/水界面における RB 会合構造のスキームを Fig. 12 に 示す.

界面領域の疎水性が一様と考えられるヘプタン/水界面 で,RBはin-plane型の会合構造であった.これは,RB のキサンテン環にあるジエチルアミノ基と界面におけるヘ プタン分子との疎水性相互作用によってRBの分子配向性 が決定されるためである<sup>14)</sup>.疎水的なTMSが石英表面に 十分に存在する場合も,同様に疎水性相互作用によって分 子配向性が決まるために,RBはin-plane型会合構造をと ると考えられる.TMSの石英表面における細密充填密度 が1nm<sup>2</sup>当たり2~3分子程度<sup>38)~40)</sup>であることを考える と,RB吸着部位には2~3分子程度のTMSが存在すると 予想される.RBのキサンテン環にある4つのジエチルア ミノ基が複数のTMSと相互作用することで,吸着RBの 分子配向性が決定されるため,界面で分子配向性のそろっ

#### BUNSEKI KAGAKU



Fig. 12 Possible schemes of the RB associates at the TMS modified-silica/water interfaces

た in-plane 型会合構造となる.一方,TMS の修飾量が小 さくなると TMS がまばらに存在し,TMS1 個に対して吸 着した RB の分子配向性はある程度自由度が生じる.この ために,水溶液中に存在する sandwich 型二量体が吸着可 能と考えられる.

#### 7まとめ

本稿で紹介したように、液/液界面及び固/液界面では、 バルク溶液中と異なる会合体が形成することが SHG スペ クトル測定によって明らかとなった.また、固/液界面で は固体表面の状態によって分子の会合状態が大きく異なる ことが分かった.このように、固体表面での機能性単分子 膜の構築において、界面の状態に応じた吸着分子の分子配 向性、分子会合状態を考慮に入れた分子設計が望まれる.

固/液界面での機能性単分子膜構築に関する研究は、セ ンサーや光エネルギー変換、触媒反応など幅広い分野で古 くから研究が行われているが、分子構造や会合構造といっ た分子レベルでの構造に関してはいまだ明らかとなってい ない問題が多い.本稿で紹介したように、第二高調波分光 法は界面領域における錯生成反応の定量的評価、分子会合 や分子配向性といった構造評価が可能であり、界面吸着分 子の状態解析手法として今後更なる応用が期待される.

本研究の一部は、文部科学省科学研究補助金「基盤研究(A) (2)」(11304054),「特定領域研究(B)」(13129201),および 「未来開拓学術研究」によったことを付記し、ここに謝意を表し ます.

#### 文 献

- H. Watarai, N. Teramae, T. Sawada (Ed.): "Interfacial Nanochemistry: Molecular Science and Engineering at Liquid-Liquid Interfaces", (2005), (Kluwar Academic/ Plenum Publishers, New York).
- 2) Y. R. Shen: "The Principles of Nonlinear Optics", (1984), (John Wiley & Sons, Inc., New York).
- 3) V. Vogel, Y. R. Shen: Annu. Rev. Mater. Sci., 21, 515 (1991).

- 4) R. M. Corn, D. A. Higgins: Chem. Rev., 94, 107 (1994).
- 5) K. B. Eisenthal: Chem. Rev., 96, 1343 (1996).
- 6) S. Yamada, I.-Y. S. Lee: Anal. Sci., 14, 1045 (1998).
- 7) T. F. Heinz, H. W. K. Tom, Y. R. Shen: *Phys. Rev. A*, 28, 1883 (1983).
- P. G. Sionnest, W. Chen, Y. R. Shen: *Phys. Rev. B*, 33, 8254 (1986).
- 9) J. E. Sipe, D. J. Moss, H. M. Van Driel: *Phys. Rev. B*, 35, 1129 (1987).
- 10) T. H. Heinz, C. K. Chen, D. Ricard, Y. R. Shen: *Phys. Rev. Lett.*, 48, 478 (1982).
- 11) S. H. Lin, R. G. Alden, A. A. Villaeys, V. Pflumio: *Phys. Rev. A.*, 48, 3137 (1993).
- 12) H. Wang, E. Borguet, K. B. Eisenthal: J. Phys. Chem. A, **101**, 713 (1997).
- 13) H. Wang, E. Borguet, K. B. Eisenthal: J. Phys. Chem. B, 102, 4927 (1998).
- 14) T. Uchida, A. Yamaguchi, T. Ina, N. Teramae: J. Phys. Chem. B, 104, 12091 (2000).
- 15) H. Nagatani, A. Piron, P.-F. Brevet, D. J. Fermin, H. H. Girault: *Langmuir*, **18**, 6647 (2002).
- 16) J. Rinuy, A. Piron, P.-F. Brevet, M. Blanchard-Desce, H. H. Girault: *Chem. Eur. J.*, **6**, 3434 (2000).
- 17) K. Nochi, A. Yamaguchi, T. Hayashita, T. Uchida, N. Teramae: *J. Phys. Chem. B*, **106**, 9906 (2002).
- 18) T. Petralli-Mallow, T. M. Wong, J. D. Byers, H. I. Yee, J. M. Hicks: *J. Phys. Chem.*, **97**, 1383 (1993).
- 19) J. J. Maki, M. Kauranen, A. Persoons: *Phys. Rev. B*, 51, 1425 (1995).
- 20) K. Fujiwara, H. Monjushiro, H. Watarai: Chem. Phys. Lett., **394**, 349 (2004).
- 21) G. T. Boyd, Y. R. Shen, T. W. Hänsch: *Opt. Lett.*, **11**, 97 (1986).
- 22) G. Peleg, A. Lewis, M. Linial, L. M. Loew: Proc. Natl. Acad. Sci. USA, 96, 6700 (1999).
- 23) A. Zoumi, A. Yeh, B. J. Tromberg: Proc. Natl. Acad. Sci. USA, 99, 11014 (2002).
- 24) A. Yamaguchi, T. Uchida, N. Teramae, H. Kaneta: Anal. Sci., 13 (Supplement), 85 (1987).
- 25) P.-G. Sionnest, W. Chen, Y. R. Shen: *Phys. Rev. B*, 33, 8254 (1986).
- 26) R. R. Naujok, D. A. Higgins, D. G. Hanken, R. M. Corn: J. Chem. Soc., Faraday Trans., **91**, 1411 (1995).
- 27) F. Sieverdes, M. Pinnow, G. Marowsky: *Appl. Phys. B*, 54, 95 (1992).
- 28) B. U. Felderhof, A. Bratz, G. Marowsky, O. Roders, F.

Sieverdes: J. Opt. Soc. Am. B, 10, 1824 (1993).

- 29) D. A. Higgins, S. K. Byerly, M. B. Abrams, R. M. Corn: J. Phys. Chem., 95, 6984 (1991).
- 30) K. K. Rohatgi, G. S. Singhal: J. Phys. Chem., 70, 1695 (1966).
- 31) J. E. Selwyn, J. I. Steinfeld: J. Phys. Chem., 76, 762 (1972).
- 32) I. L. Arbeloa, P. R. Ojeda: Chem. Phys. Lett., 87, 556 (1982).
- 33) M. Kasha, H. R. Rawls, M. A. El-Bayoumi: Pure Appl. Chem., 11, 371 (1965).
- 34) D. G. I. Kingston, B. B. Gerhart: J. Chromatogr., 116,

182 (1976).

- 35) M. J. Snare, K. L. Tan, F. E. Treloar: J. Macromol. Sci. Chem., 17, 189 (1982).
- 36) J. Muto: J. Phys. Chem., 80, 1342 (1976).
- 37) K. Bessho, T. Uchida, A. Yamauchi, T. Shioya, N. Teramae: *Chem. Phys. Lett.*, **264**, 381 (1997).
- 38) W. K. Lowen, E. C. Broge: J. Phys. Chem., 65, 16 (1966).
- 39) D. W. Sindorf, G. E. Maciel: J. Phys. Chem., 86, 5208 (1982).
- 40) A. Y. Fadeev, V. A. Eroshenko: J. Colloid Interface Sci., 187, 275 (1997).

## Analysis of Associated Structures of Rhodamine B Adsorbed at Interfaces by Second Harmonic Generation Spectroscopy

Akira YAMAGUCHI<sup>1</sup>, Tatsuya UCHIDA<sup>1,2</sup>, Tomomi INA<sup>1</sup>, Kimihisa NOCHI<sup>1</sup> and Norio TERAMAE<sup>1</sup>

<sup>2</sup> Present address, Laboratory of Environmental Chemodynamics, Tokyo University of Pharmacy & Life Science, 1432 - 1, Horinouchi, Hachioji-shi, Tokyo 192 - 0392

(Received 3 February 2006, Accepted 24 March 2006)

We have developed an apparatus for the measurement of second harmonic generation (SHG) spectra that provide direct evidence on the electronic structures of interfacial species. By applying the measurement apparatus, we have studied molecular association of rhodamine B (RB) at a heptane/water interface and trimethylchlorosilane (TMS) modified-quartz/water interfaces with a different coverage. The observed SHG spectra at the heptane/water interface showed red-shift of the peak maxima compared to the absorption maximum of monomeric RB in the bulk aqueous phase, and these spectra indicated predominant formation of in-plane associates in which the electronic transition dipoles of each monomer were arranged parallel to one another. At the TMS-modified-quartz/water interface, spectral shape of SHG spectra was almost same with that found in the heptane/water interface when the surface density of TMS was high. In contrast, with decreasing the surface density of TMS, the red-shifted peak due to the in-plane associates become weaker, and other peaks due to a sandwich dimmer appeared. We confirmed that the association form of RB depended on the surface density of TMS.

Keywords : second harmonic generation; interface; molecular association; rhodamine dye.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Department of Chemistry, Graduate School of Science, Tohoku University, Aramaki, Aoba-ku, Sendai-shi, Miyagi 980-8578